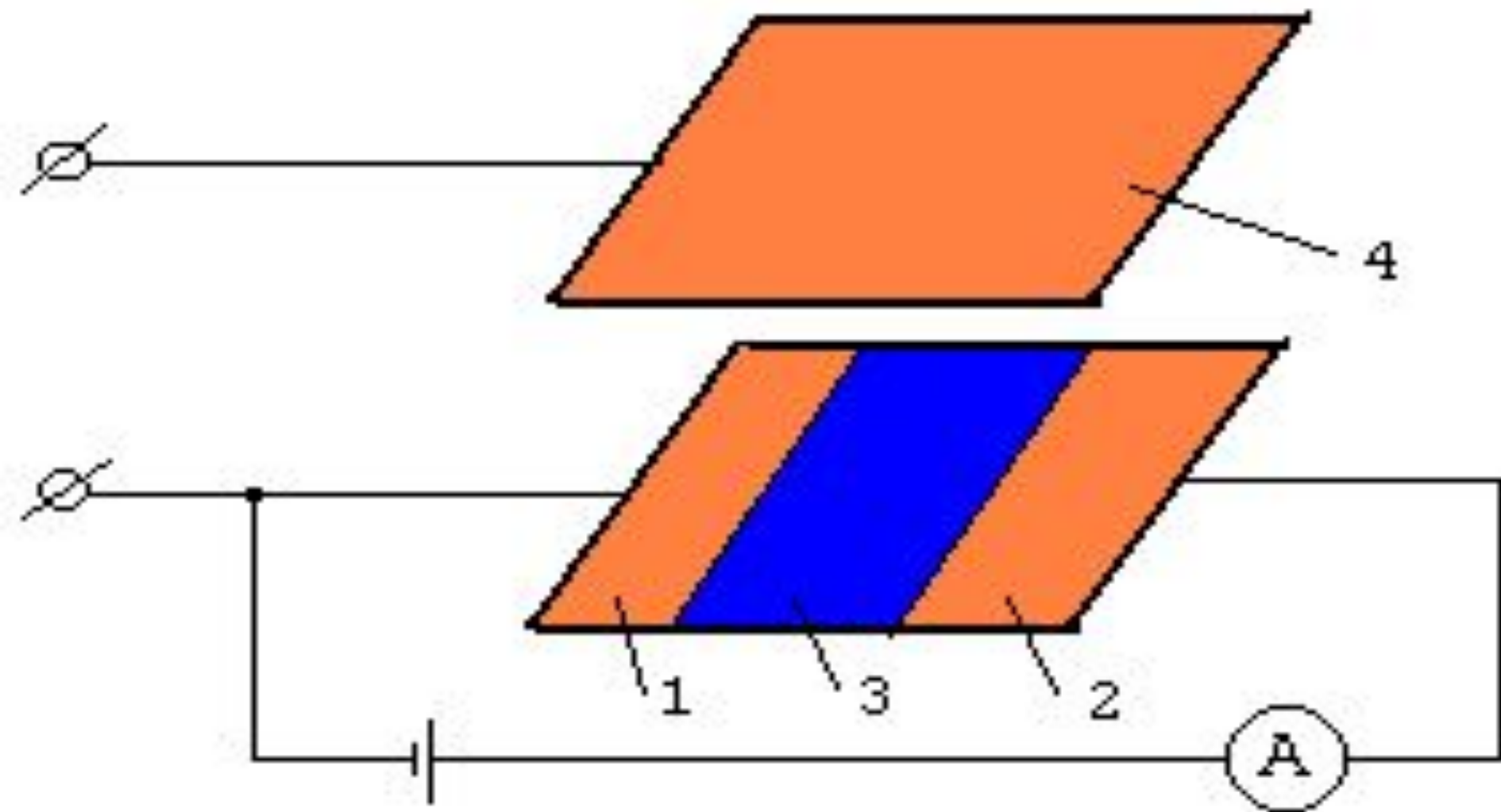


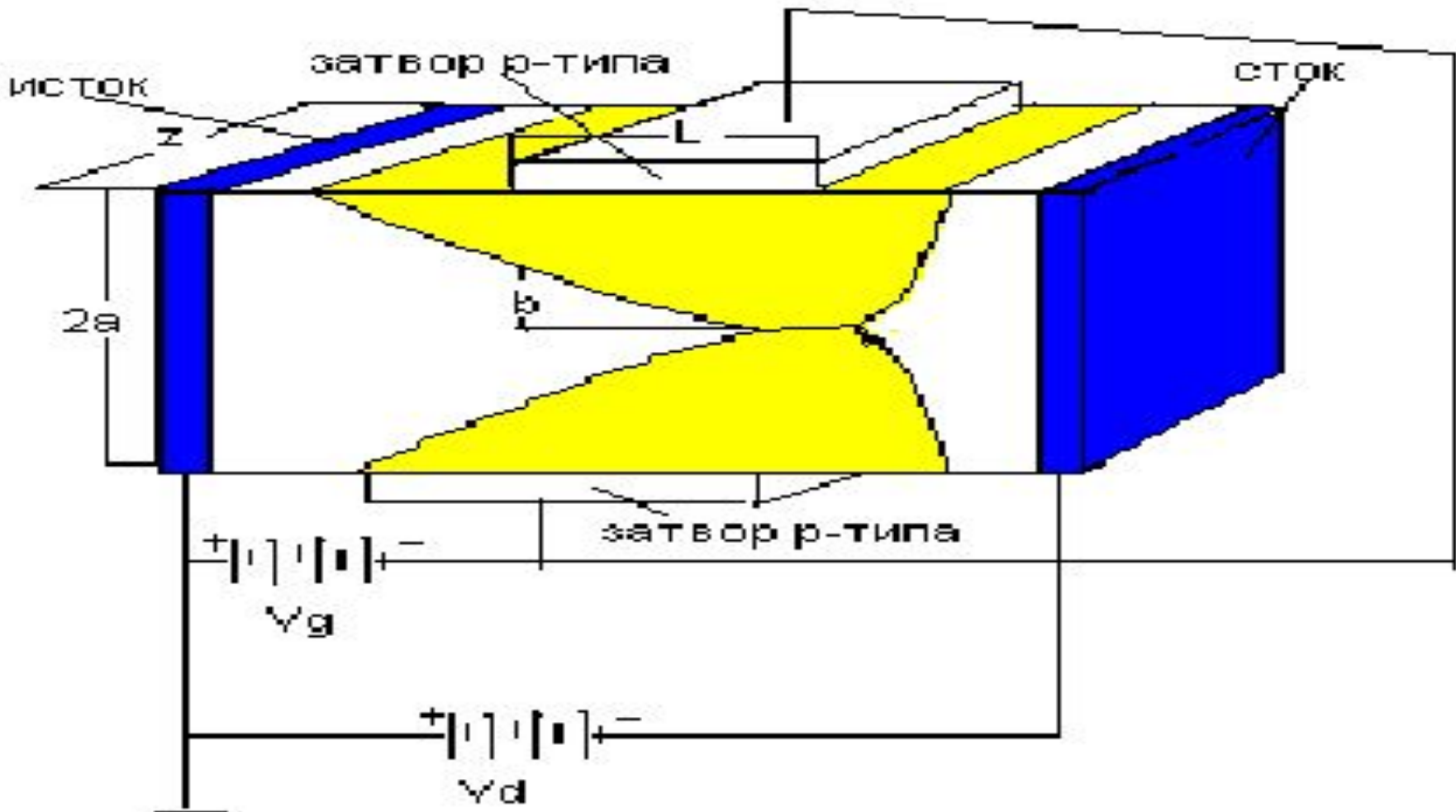
Полевые транзисторы (иллюстрации).

Ночовнова А.Л. 21302

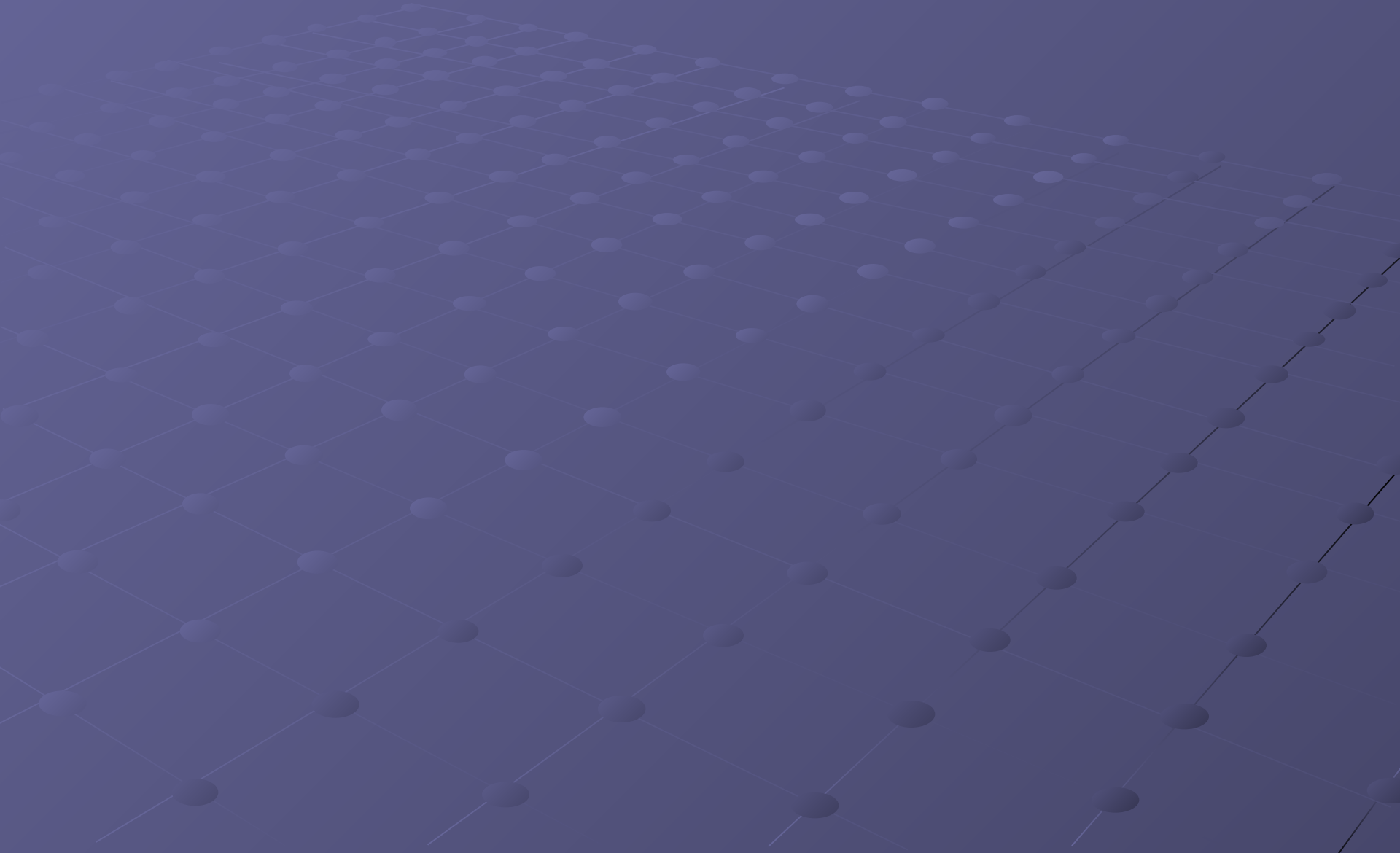
Униполярный транзистор Хейла



Схематичное изображение полевого транзистора согласно Шокли



Принцип работы



Стоковые характеристики

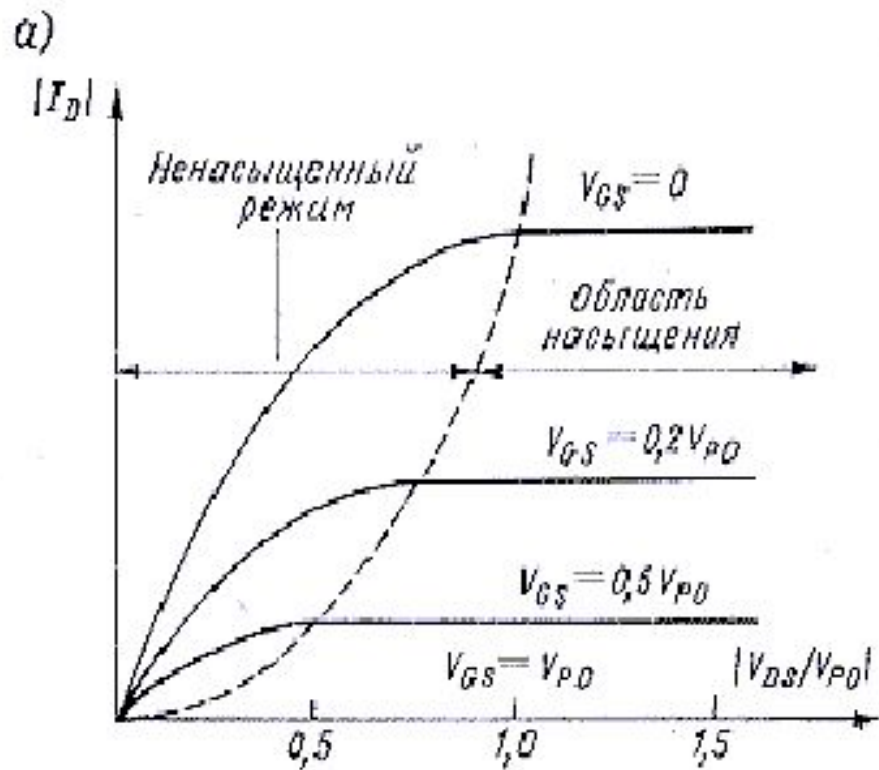
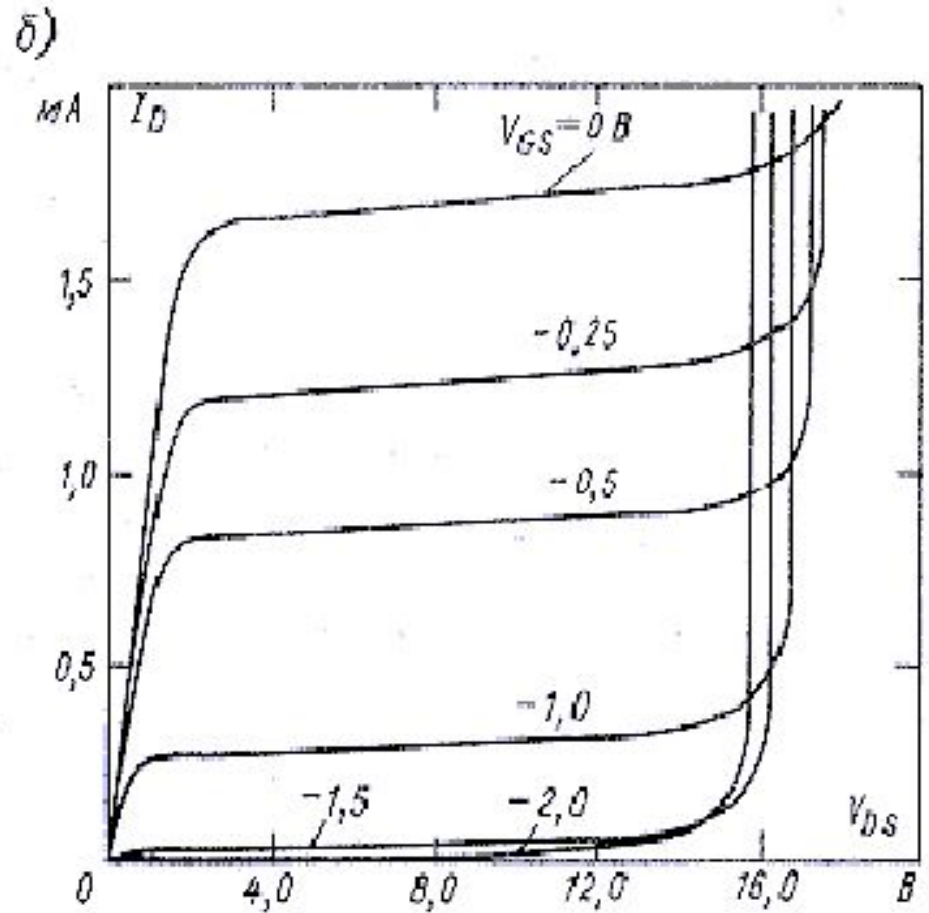
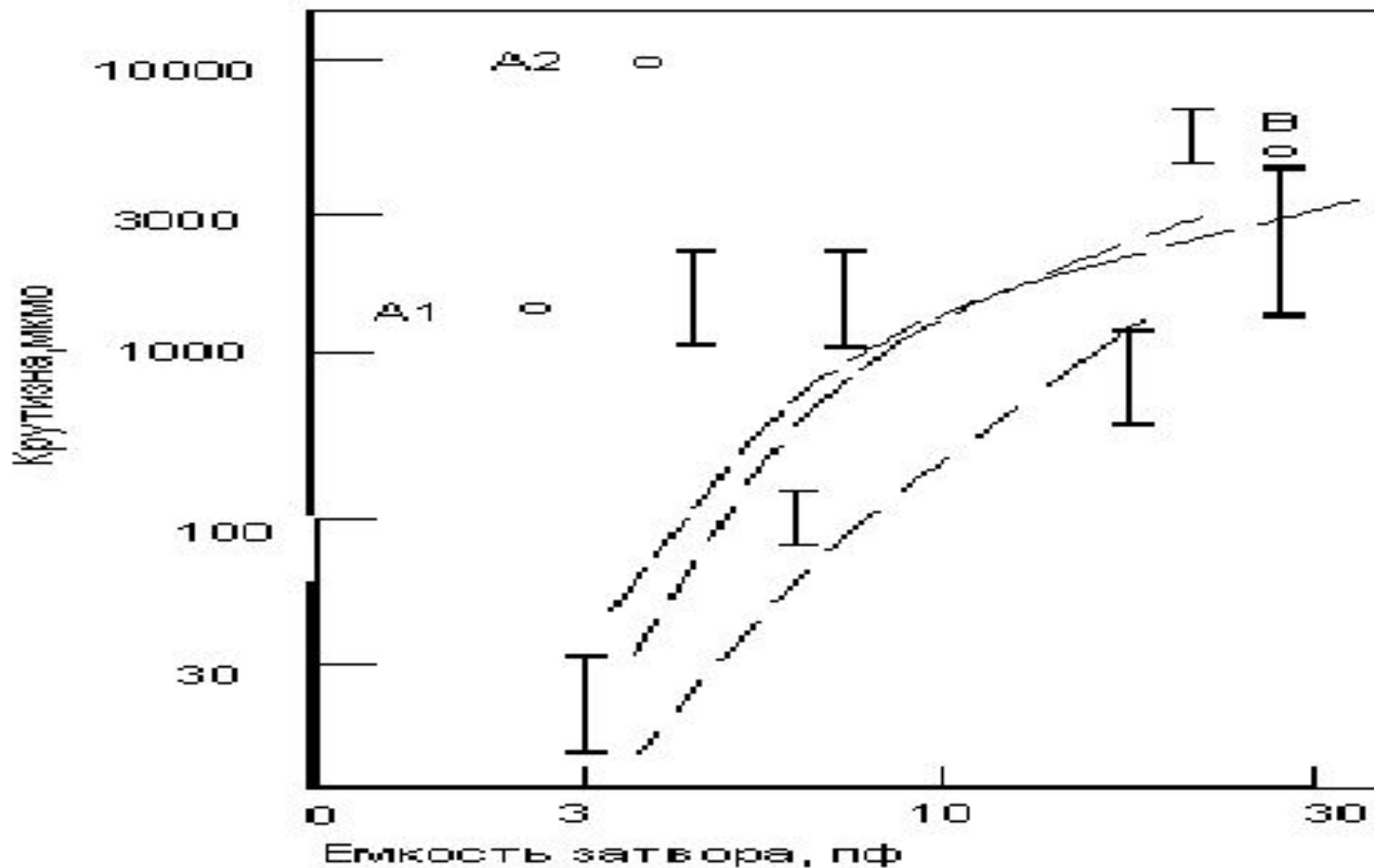


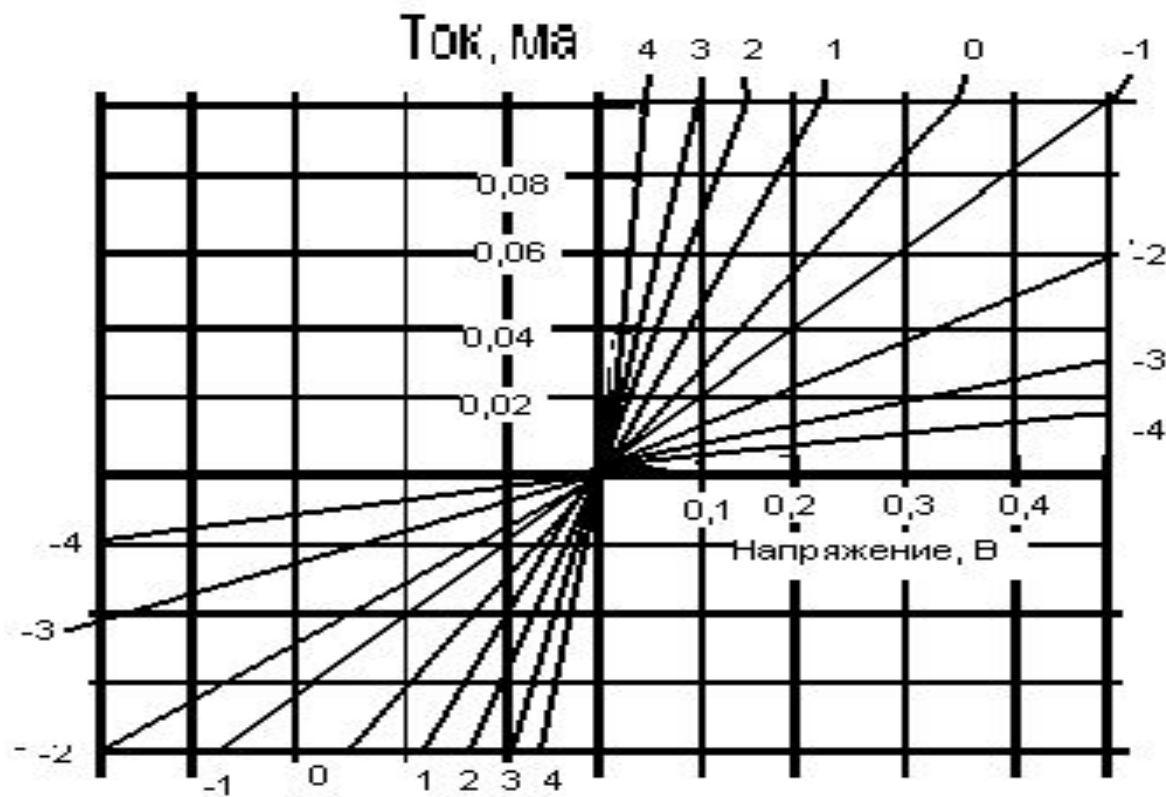
Рис. 2



Крутизна полевых транзисторов в зависимости от суммарной емкости затвора



Зависимость тока стока от напряжения на стоке при различных напряжениях на затворе.



Зависимость тока стока от напряжения на стоке при различных напряжениях на затворе

Полупроводниковые материалы пригодные для изготовления полевых транзисторов

Группа в периодической системе Менделеева	Полупроводниковый материал
I-V	Cs3Sb*
I-VI	Cu2O+
II-IV	Mg2Sn* Mg2Si*
II-VI	CdS+ CdTe* ZnO+ ZnS+ CdSe+
III-V	GaAs*+ GaSb* GaP*+ AlSb* InSb* InP*+ InAs*
IV	Ge*#+ Si*+ SiC*#
IV-VII	PbS*# PbSe* PbTe* TiO2+
V-VI	Bi2Te3*
VI	Te*
VI-VIII	NiO+

*-возможность создания p-n перехода

+ - величина удельного сопротивления позволяет использовать данный полупроводник для создания униполярного транзистора

- полупроводник с временем жизни носителей пригодным для биполярного транзистора

Зависимость крутизны от температуры

